

В заключение отметим, что механизм электронной нелинейности, действующий при неколлинеарной генерации второй гармоники, сочетает эффективность 10^{-5} - 10^{-3} с субпикосекундными временами отклика [1], что позволяет кодировать цифровую информацию оптическими импульсами с длительностью $\tau = 0.1 \dots 10$ пс и реализовывать обширные сети оптически связанных вентилей с многократным использованием исходных световых пучков в последовательных актах взаимодействия, достигая в результате указанных выше значений производительности при энергетических затратах на каждое логическое умножение 10^{-15} - 10^{-11} Дж/бит.

Список литературы

- [1] Eichmann G., Li Y., He P.P., Alfan R.R. // Appl. Opt. 1987. V. 26. N 14. P. 2726-2733.
- [2] Li Y., Eichmann G., Alfan R.R. // Opt. Commun. 1987. V. 64. N 2. P. 99-104.
- [3] Беришев И.Э., Раковский В.Ю., Селищев А.В., Щербаков А.С. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 8. С. 14-18.
- [4] Раковский В.Ю., Щербаков А.С. // Оптические и оптоэлектронные средства обработки информации. Л.: ЛИЯФ-ФТИ. 1989. С. 68-76.
- [5] Psaltis D., Athale R.A. // Appl. Opt. 1986. V. 25. N 18. P. 3071-3077.

Поступило в Редакцию
28 марта 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 10
04; 07; 09

26 мая 1990 г.

© 1990

ОПТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ВЧ-РАЗРЯДЕ,
ВОЗБУЖДАЮЩЕМ CO_2 ЛАЗЕР

А.В. К а л м ы к о в, А.С. С м и р н о в

Оптогалванический эффект в разряде постоянного тока, возбуждающем CO_2 лазер, широко используется для стабилизации частоты генерируемого излучения [1]. Полезным сигналом в таких устройствах является изменение тока или напряжения на разряде, вызванное излучением. Характерное значение этого сигнала составляет доли процента. Использование метода ВЧ-возбуждения активной среды приводит к значительным трудностям при регистрации

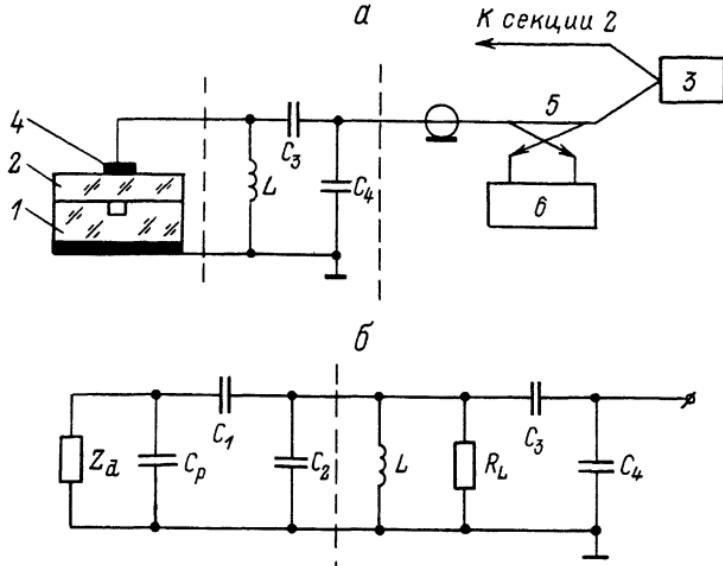


Рис. 1. Схема экспериментальной установки (а) и эквивалентная схема нагрузки генератора (б).

подобных сигналов: измерения тока и напряжения с высокой точностью являются в этом случае сложной самостоятельной задачей. Обычно используют измерения абсолютной величины коэффициента отражения в цепи источника ВЧ-мощности [2]. Полезный сигнал в этом случае также является малым. Повысить чувствительность можно, измеряя величину фазы коэффициента отражения, которая сильно зависит от характеристик разряда.

В настоящей работе описаны результаты исследований фазы коэффициента отражения в разряде на частоте 80–90 МГц, возбуждающем волноводный лазер. Все эксперименты проводились при давлении 100 Тор в газовой смеси $\text{CO}_2 : N_2 : He : Xe = 2 : 1 : 6.7 : 0.74$. Конструкция установки поясняется рис. 1, а. Разряд создавался в канале сечением 2×2 мм, длиной 196 мм. Детали разрядной камеры (1, 2) изготавливались из лейкосапфира. ВЧ-мощность поступала от транзисторного генератора (3) с выходным сопротивлением 50 Ом и мощностью до 100 Вт. Для повышения однородности разряда потенциальный электрод (4) состоял из двух секций, подключаемых к генератору с использованием индивидуальных схем согласования и делителей мощности. Характеристики разряда в каждой из секций являлись идентичными, поэтому все данные приводятся для одной секции. Система согласования включала в себя катушку индуктивности L и два конденсатора C_3 и C_4 . На рис. 1, б представлена эквивалентная схема нагрузки генератора. На этой схеме Z_d – импеданс разряда, C_p – емкость канала, C_1 – балластная емкость, C_2 – паразитная емкость прибора; L , C_3 , C_4 – детали системы согласования (рис. 1, а). R_L – приведенное сопротивление потерь в элементах схемы. Величина эквивалентного сопротивления нагрузки Z

определялась по амплитудам отраженной и подающей волн U , U_G и фазовому сдвигу φ между ними. Указанные величины измерялись направленным ответвителем (5) с измерителем разности фаз ФК2-12(6) (рис. 1, а).

В отсутствии лазерной генерации устанавливался стационарный режим с величиной комплексного коэффициента отражения К:

$$K(z) = \frac{U}{U_G} \cdot e^{i\varphi} = \frac{Z - W}{Z + W}. \quad (1)$$

Здесь $W=50$ Ом – волновое сопротивление тракта. При этом в разряд вкладывалась мощность Q :

$$Q \sim U_G^2 (1 - |K(z)|^2). \quad (2)$$

На рис. 2, а приведены экспериментально полученные значения φ в зависимости от частоты ВЧ-поля $\frac{\omega}{2\pi}$ в диапазоне устойчивого горения разряда. Стрелкой показана резонансная частота ω_0 ,

при которой эквивалентное сопротивление нагрузки является чисто активным и коэффициент отражения минимален. В соответствии с (1) вид зависимости $\varphi(\omega)$ определяется величиной $\Delta = Re Z - W$. Кривые 1, 2 соответствуют различным значениям Δ . При $\Delta < 0$ фаза коэффициента отражения испытывает скачок от $-\pi$ до π при $\omega = \omega_0$ (кривая 1). При $\Delta > 0$ зависимость $\varphi(\omega)$ является монотонной (кривая 2). Так как $Re Z$ зависит от вкладываемой мощности Q и других характеристик разряда, то при малых коэффициентах отражения, которые соответствуют малым Δ , флуктуации параметров разряда могут привести к переходу с одной ветви зависимости $\varphi(\omega)$ на другую. Кривые 1 и 2 рис. 2, а получены в двух последовательных средах измерений при $Q \approx 50$ Вт, при этом все параметры разряда поддерживались неизменными в пределах точности измерений. Для кривой 1 минимальное значение коэффициента отражения составляло $|K|_{min} = 0.02$; для кривой 2 – $|K|_{min} = 0.05$. Таким образом, для корректных измерений фазы необходимо поддерживать $\Delta > 0$.

При наличии лазерной генерации мощность излучения Q_R возрасла с увеличением вкладываемой мощности. Максимальное значение $Q_R = 3.7$ Вт ограничивалось качеством используемых зеркал. При этом амплитуда отраженной волны снижалась до значения U_R , а значение φ уменьшалось до φ_R . При $Q_R = 3$ Вт относительное изменение амплитуды отраженной волны $\delta U = (U - U_R)/U$ составляло 1.5 %. Величина δU практически не зависела от частоты и $|K|$ и определялась только Q_R и Q , в то время как изменение фазы $\Delta\varphi = \varphi - \varphi_R$ вело себя более сложным образом. Максимальные значения $\Delta\varphi$ отмечались вблизи минимума $|K|$. На рис. 2, б представлены зависимости $\Delta\varphi$ и Q_R от суммарной мощности, вкладываемой в обе секции разряда Q_Σ . Кривые

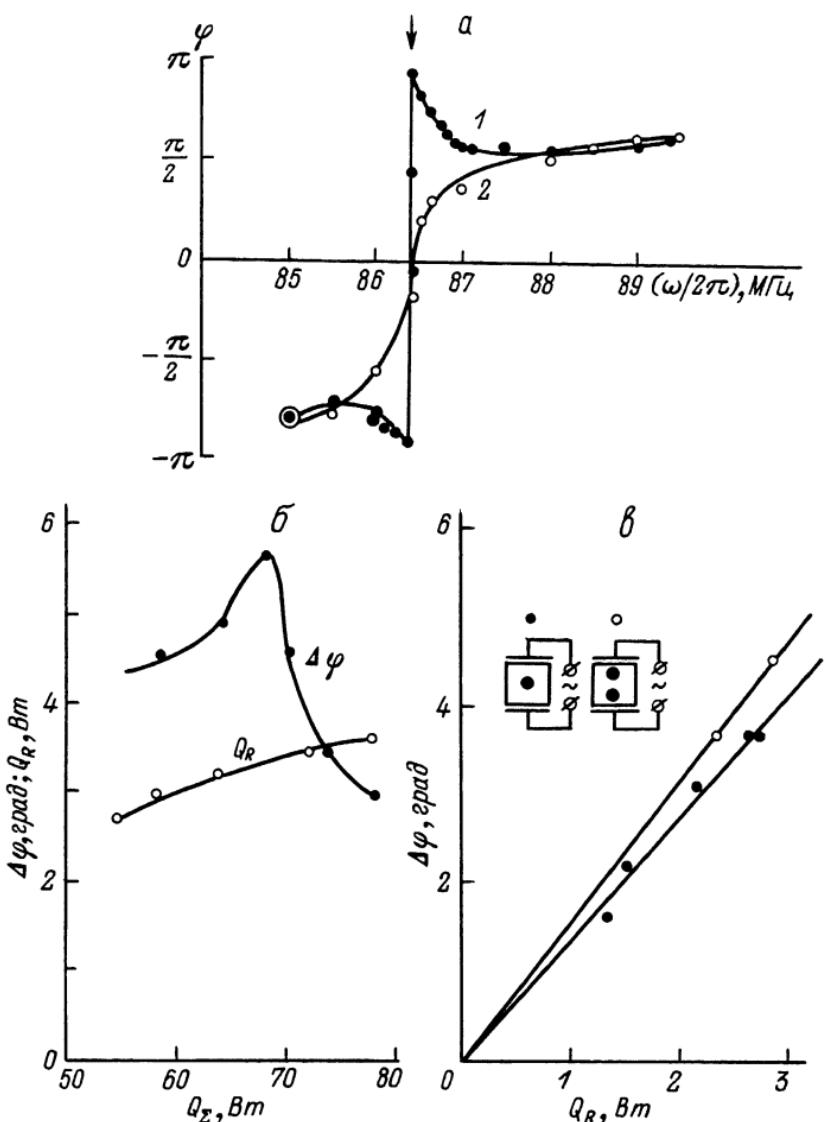


Рис. 2. Зависимости фазы коэффициента отражения от частоты (а), фазового сдвига от вкладываемой мощности (б) и от мощности генерации (в).

снимались при фиксированной частоте, изменение Q_Σ обеспечивалось изменением выходной мощности генератора. Видно, что зависимость $\Delta\varphi$ от Q_Σ имеет хорошо выраженный максимум при $Q_\Sigma \approx 65$ Вт, в то время как соответствующие значения Q_R монотонно возрастили от 3 до 3.7 Вт при увеличении вкладываемой мощности от 60 Вт до 80 Вт. В тех случаях, когда изменение Q_R обеспечивалось чисто оптическими методами без нарушения электрических режимов работы отмечался монотонный линейный рост $\Delta\varphi$ с ростом мощности генерации. На рис. 2, в приведена зависимость $\Delta\varphi$ от Q_R , полученная для двух поперечных мод,

отличающихся расположением максимумов светового поля относительно электродов. Изменение фазы для основной волноводной моды несколько меньше, чем для моды высшего порядка. Возможная причина этого в большем объеме активной среды, занимаемом такой модой. Кроме того, максимумы светового поля вблизи электродов могут оказывать влияние на приэлектродные слои разряда, вклад которых в χ является значительным [3]. Следует отметить, что с повышением точности измерений возможна индикация поперечных мод, основанная на величине фазового сдвига.

Таким образом, экспериментально установлено, что лазерная генерация в ВЧ-разряде приводит к изменению фазы коэффициента отражения. В режимах работы вблизи резонанса это изменение достигает нескольких градусов, что делает фазовые измерения весьма чувствительным методом изучения оптогальванического эффекта.

Список литературы

- [1] Очкин В.Н., Преображенский Н.Г. и др. // УФН. 1986. Т. 148. В. 3. С. 473-507.
- [2] Ануфриев Э.В., Бирюлин В.П. и др. // Квантовая электроника. 1988. № 8. С. 1664-1669.
- [3] Калмыков А.В., Смирнов А.С. В кн.: Всесоюзный семинар по высокочастотному пробою газов. Тезисы докладов, Тарту, 1989, С. 183-185.

Ленинградский
политехнический институт
им. М.И. Калинина

Поступило в Редакцию
19 марта 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 10

26 мая 1990 г.

05.2; 05.3

© 1990

ЭФФЕКТ ИОННОЙ КОМПЕНСАЦИИ
В ВОССТАНОВЛЕННОЙ КЕРАМИКЕ ТИТАНАТА СТРОНЦИЯ

А.Е. Гелясий, И.А. Шкраб

В работе сообщается об эффекте ионной компенсации при легировании ниобием сильновосстановленной керамики титаната стронция, приводящем к переходу от металлического типа проводимости к полупроводниковому.

Известно, что керамический титанат стронция, легированный ниобием, являющейся донорной примесью, обладает полупроводниковым типом проводимости с проявляющимися при температуре ниже 500 К аномалиями [1]. При сильном восстановлении титанат